

ブリッジダイオード 低VF・低ノイズタイプ シングルインライン型
Bridge Diode Low VF·Low Noise type Single In-line Package

LL15XB60

600V 15A

特長

- 薄型SIPパッケージ
- 低ノイズ・低VF
- 大電流容量
- UL E142422
- 高放熱伝導性

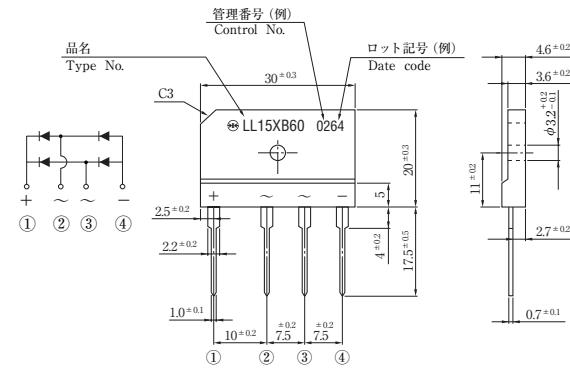
Feature

- Thin-SIP
- Low Noise · Low VF
- Large Io
- UL E142422
- High Thermal Radiation

■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

Package : M1F

Unit : mm
Weight : 7.1g (typ.)



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

■定格表 RATINGS

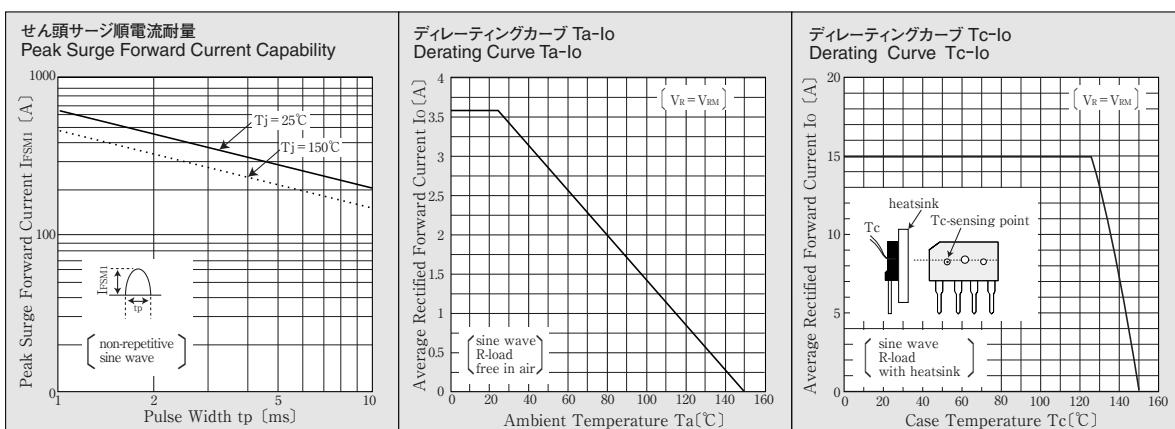
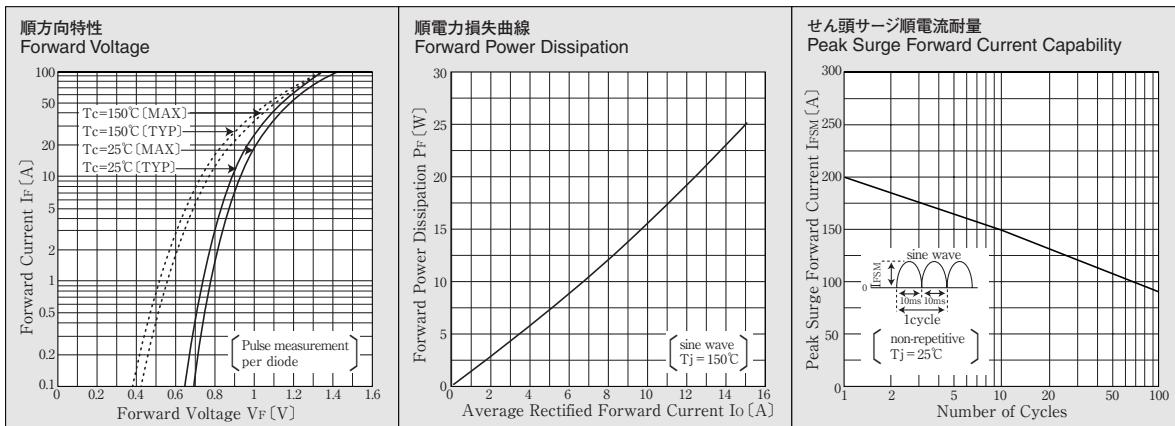
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	LL15XB60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フィン付き With heatsink $T_c=124^\circ\text{C}$	15	A
			フィンなし Without heatsink $T_a=26^\circ\text{C}$	3.6	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j=25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $T_j=25^\circ\text{C}$		200	A
	I _{FSM1}	tp=1ms 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j=25^\circ\text{C}$ tp=1ms sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $T_j=25^\circ\text{C}$		630	
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	$1\text{ms} \leq t < 10\text{ms}$ $T_j=25^\circ\text{C}$ —素子当たりの規格値 per diode		200	A ² s
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2.5	kV
締め付けトルク Mounting Torque	T _{OR}	(推奨値: 0.5 N·m) (Recommended torque : 0.5 N·m)		0.8	N·m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =7.5A, パルス測定, 一素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	TYP 0.86	MAX 0.90	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =600V, パルス測定, 一素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode		MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I _F =0.1A, I _R =0.1A, 一素子当たりの規格値 per diode		MAX 3.0	μs
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間, フィン付き Junction to Case, With heatsink		MAX 1.0	°C/W
	θ _{jl}	接合部・リード間, フィンなし Junction to Lead, Without heatsink		MAX 5.0	
	θ _{ja}	接合部・周囲間, フィンなし Junction to Ambient, Without heatsink		MAX 25	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- Sine wave は 50Hz で測定しています。
- 50Hz sine wave is used for measurements.
- 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。Typical は統計的な実力を表しています。
- Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.